

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

Тезисы докладов представляются на русском или английском языках в объеме 1 страницы формата А4.

Образец и правила оформления тезисов размещены на сайте конференции <http://crystal.isc-ras.ru>.

От одного участника Конференции может быть представлено не более двух докладов (но участник может быть содокладчиком других докладов). Название файла должно содержать фамилию и инициалы автора на английском языке. Например, IvanovSP.doc (если автор предоставляет 2 доклада, то название второго доклада IvanovSP2.doc). Файл должен быть создан с помощью программы MS Word версий 2000, 2002, 2003. Файлы с расширением docx к рассмотрению не принимаются. Размер файла не должен превышать 2 Мб.

Оргкомитет оставляет за собой право изменить вид доклада и секцию, уведомив об этом докладчика.

Подачу тезисов необходимо осуществлять **исключительно в режиме on-line** на сайте конференции <http://crystal.isc-ras.ru>. Последний срок представления тезисов **15 мая 2012 г.**

Публикация тезисов докладов возможна только при оплате оргвзноса **до 15 июня 2012 г.** При оплате оргвзноса после этого срока тезисы докладов в сборник **не будут включены.**

Тезисы докладов, оформленные не по правилам и присланные с опозданием, рассматриваться не будут.

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

153045, г. Иваново, ул. Академическая, 1. ИХР РАН

Fax: (4932)336259, Тел. (4932)336259

E-mail: crystal2012@isc-ras.ru,

Сайт конференции: <http://crystal.isc-ras.ru>

Ученый секретарь:

к.х.н. Алексеева Ольга Владимировна

Тел. (4932)351859.

Все контакты с членами оргкомитета

осуществляются посредством внутренней почты, доступной только для зарегистрированных участников конференции через личный профиль на сайте конференции.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

Для зарубежных участников:

Участник конференции - **150 €**

Сопровождающее лицо - **100 €**

Аспирант, студент – **100 €**

Для граждан России и СНГ

Участник конференции - **1700 руб.**

Аспирант, студент - **800 руб.**

Сопровождающее лицо - **800 руб.**

Заочное участие в конференции - **500 руб.**

Регистрационный взнос включает оплату за печатание сборника докладов, информационных материалов, аренду помещений и транспорта, перерывы на кофе, фуршет и другие организационные расходы.

Рассылка сборника заочным участникам конференции не предусматривается.

Электронная версия материалов конференции будет опубликована на сайте конференции по ее окончании.

Реквизиты для перечисления денег будут опубликованы на сайте конференции
<http://crystal.isc-ras.ru>.

Копия платежного поручения представляется в режиме on-line на сайте конференции или по электронной почте.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Организационный комитет приглашает российские и зарубежные фирмы выступить в качестве спонсоров VII-ой Международной научной конференции «Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация и материалы нового поколения». Подробная информация размещена на сайте конференции <http://crystal.isc-ras.ru>.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

Завершение подачи заявок на участие – **16 апреля 2012 г.**

Завершение подачи тезисов – **15 мая 2012 г.**

Крайний срок оплаты оргвзноса – **15 июня 2012 г.**

Завершение бронирования проживания – **15 июня 2012 г.**

Второе информационное сообщение – **10 июня 2012 г.**

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ
русский и английский.

Российская академия наук
Научный совет по химической технологии
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН
Министерство образования и науки РФ
Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова
Ивановский государственный
химико-технологический университет
Российское химическое общество
им. Д.И. Менделеева

VII Международная научная
конференция

**«КИНЕТИКА И МЕХАНИЗМ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ.
КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»**



<http://crystal.isc-ras.ru>

Иваново, Россия
25 - 28 сентября 2012 г.

Первое информационное сообщение

С 25 по 28 сентября 2012 года в г. Иваново будут проходить VII-я Международная научная конференция «Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация и материалы нового поколения» и II Всероссийская школа молодых ученых по кинетике и механизму кристаллизации

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

Председатель оргкомитета
чл.-корр. РАН **Мелихов И.В.** (МГУ, Москва)
Сопредседатель
проф. **Захаров А.Г.** (ИХР РАН, Иваново)
Ученый секретарь
к.х.н. **Алексеева О.В.** (ИХР РАН, Иваново)

акад. РАН Алдошин С.М. (ИПХФ РАН, Черноголовка)
чл.-корр. РАН Алымов М.И. (ИМЕТ РАН, Москва)
проф. Агеев Е.П. (МГУ, Москва)
проф. Бауэр-Брендл А. (Дания)
чл.-корр. РАН Баринов С.М. (ИМЕТ РАН, Москва)
чл.-корр. РАН Бачурин С.О. (ИФАВ РАН, Черноголовка)
д.х.н. Бердонос С.С. (МГУ, Москва)
проф. Блиничев В.Н. (ИГХТУ, Иваново)
к.х.н. Божевольнов В.Е. (МГУ, Москва)
чл.-корр. РАН Бойнович Л.Б. (ИФХЭ РАН, Москва)
проф. Велага С. (Швеция)
чл.-корр. РАН Гудилин Е.А. (МГУ, Москва)
чл.-корр. РАН Гусаров В.В. (ИХС РАН, С.-Петербург)
проф. Дехаен В. (Бельгия)
акад. РАН Дианов Е.М. (ИОФ РАН, Москва)
акад. РАМН Егоров А.М. (МГУ, Москва)
проф. Идрисси А. (Франция)
акад. РАН Иевлев В.М. (ГТУ, Воронеж)
акад. РАН Каблов Е.Н. (ВИАМ, Москва)
проф. Каманина Н.В. (НИК "ТОИ им. Вавилова", С.-Петербург)
д.х.н. Киселев М.Г. (ИХР РАН, Иваново)
чл.-корр. РАН Койфман О.И. (ИГХТУ, Иваново)
проф. Колкер А.М. (ИХР РАН, Иваново)
проф. Кулов Н.Н. (ИОНХ РАН, Москва)
акад. РАН Лунин В.В. (МГУ, Москва)
акад. РАН Мержанов А.Г. (ИСМАН РАН, Черноголовка)
д.х.н. Перлович Г.Л. (ИХР РАН, Иваново)
проф. Рашкович Л.Н. (МГУ, Москва)
акад. РАН Саркисов П.Д. (РХТУ, Москва)
акад. РАН Солнцев К.А. (ИМЕТ РАН, Москва)
акад. РАН Третьяков Ю.Д. (МГУ, Москва)
д.м.н. Трещалина Е.М. (ГУ РОНЦ, Москва)
проф. Усольцева Н.В. (ИвГУ, Иваново)

проф. Федоров М.В. (Шотландия)
проф. Федоров П.П. (ИОФ РАН, Москва)
акад. РАН Холькин А.И. (ИОНХ РАН, Москва)
акад. РАН Цветков Ю.В. (ИМЕТ РАН, Москва)
акад. РАН Цивадзе А.Ю. (ИФХЭ РАН, Москва)
чл.-корр. РАН Чекмарев А.М. (РХТУ, Москва)
чл.-корр. РАН Чернов А.А. (ИК РАН, Москва; США)
акад. РАН Чурбанов М.Ф. (ИХВВ РАН, Н. Новгород)
проф. Шарнин В.А. (ИГХТУ, Иваново)
проф. Щеблыкин И.Г. (Швеция)
акад. РАН Шевченко В.Я. (ИХС РАН, С.-Петербург)
чл.-корр. РАН Ярославцев А.Б. (ИОНХ РАН, Москва)

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Секция I.

Фундаментальные основы оптимальных технологий кристаллических материалов

- Теория образования кристаллического вещества в средах высокого пересыщения.
- Модели процессов кристаллизации. Механизмы образования, растворения, и топохимического превращения кристаллов.
- Кристаллизационные процессы при термическом, химическом и механическом модифицировании твердых веществ.
- Механизм кристаллизации при сверхкритических параметрах состояния.
- Критерии оптимальности технологических вариантов превращения кристаллических веществ в материал.

Секция II.

Функциональные и конструкционные материалы

- Модели управления процессами при получении материалов.
- Методология оптимального синтеза порошкообразных и керамических материалов, нанесения покрытий и получения магнитных и электрореологических жидкостей.
- Материалы для электроники и оптики. Управление кристаллизацией при создании материалов и особо чистых веществ.
- Кинетика зарождения и развития жидкокристаллических и полимерных образований. Модели образования полимерных пленок и кристаллизации в их объеме.
- Композиты на основе жидких кристаллов и полимеров, как материалы нового поколения.

Секция III.

Материалы для медицины

- Методология создания материалов медицинского назначения.
- Механохимический синтез. Получение лекарственных препаратов при сверхкритических параметрах состояния.
- Получение и исследование полиморфных и псевдополиморфных форм молекулярных кристаллов; проблемы разделения энантиомеров лекарственных веществ.
- Получение/Дизайн и исследование растворимых форм лекарственных соединений. Создание новых средств доставки физиологически активных субстанций.
- Проблемы биокристаллизации и биоподобных материалов.

Международный симпозиум.

«Конформационно подвижные биоактивные соединения: Синтез, псевдополиморфизм и фотофизические свойства».

На пленарных и секционных заседаниях будут представлены лекции, устные и стендовые доклады, а также проведены мастер-классы выдающихся ученых-исследователей в области процессов кристаллизации, круглые столы и конкурс работ молодых ученых.

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация участников конференции и представление тезисов докладов осуществляется через Интернет на веб-сайте конференции <http://crystal.isc-ras.ru> с помощью интерактивных форм до 16 апреля 2012 г.

Регистрация посредством почты, электронной почты, телефона и факса невозможна.

Регистрацию проходят только участники конференции, члены организационного комитета. Сопровождающие лица регистрацию не проходят. Всю информацию о сопровождающих лицах вносят в соответствующие формы участники конференции, которых эти лица сопровождают. Для зарегистрированных пользователей создается личный профиль, в котором он имеет возможность редактировать свою персональную информацию, заполнять регистрационные формы по этапам, пользоваться внутренней почтой. Прохождение участниками конференции этапов регистрации (размещение тезисов докладов, подтверждение оплаты оргвзноса, бронирование гостиницы, наличие сопровождающих лиц) отражено в разделе "Участники конференции".